Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2002222758

PUBLICATION DATE

09-08-02

APPLICATION DATE

29-01-01

APPLICATION NUMBER

2001019522

APPLICANT: CANON INC:

INVENTOR :

MIYAJIMA GIICHI;

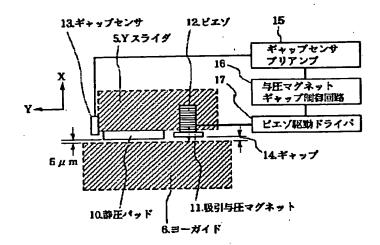
INT.CL.

H01L 21/027 G03F 7/20 H01L 21/68

TITLE

STAGE SYSTEM AND EXPOSURE

APPARATUS USING IT



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a stage system which can reduce the fluctuating amount of a gap that occurs when a mobile stage section moves in steps, and to provide an exposure apparatus which is provided with the stage system and can be improved in throughput and exposure accuracy.

SOLUTION: The stage system has a mobile stage which can move while the stage is mounted with both an original plate and a substrate or the substrate, a static pressure pad 10 which guides the mobile stage while the pad 10 supports the stage against a stage pedestal and/or a yaw guide 6, and means (an attracting and pressurization magnet 11, a piezoelectric element 12, a gap sensor 13, etc.), which control at least either one of the attracting force and gap between the mobile stage and the stage pedestal and/or yaw guide 6.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

				•		٠
					en Norden e general de la companya d	. i
		***	$\theta_{(p)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} \left(\frac{1}{p} \right) - \frac{1}{p} \left(\frac{1}{p} \right) \right)$	7		
			ja.	t		
		i i				
-		· · ·				
			•			
		· .		, 1		
			·	•		
			2	* *		
*.						
		, '				
				•		•
			***************************************	•		
		*.				
					eren e	
			्र केश -	٠		
	en leg e si					
		•	ing a specific			
			St.		•	
			•		•	
			A Company of the second			

			n garage said and a said			
		•			• .	

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-222758 (P2002-222758A)

(43)公開日 平成14年8月9日(2002.8.9)

(51) Int.Cl.7		識別記号	識別記号 FI		·	
HOIL	21/027		G03F	7/20	5 2 1	5 F O 3 1
GOSF		5 2 1	H01L	21/68	K	5 F O 4 6
HO1L				21/30	515F	•
HUIL	21/00				515G	

寒香語求 未請求 請求項の数19 OL (全 14 頁)

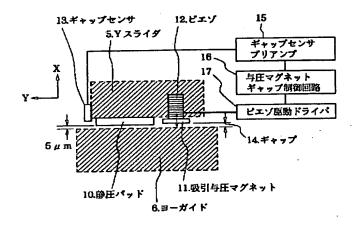
	•	審查請求 未請求 請求項の数19 〇L (全 14 貝)
(21)出願番号	特願2001-19522(P2001-195 22)	(71)出願人 000001007 キヤノン株式会社
(22)出願日	平成13年1月29日(2001.1.29)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 宮島 嶽一 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ ン株式会社内 (74)代理人 100086287 弁理士 伊東 哲也
· .		F ターム(参考) 5F031 CA02 HA53 JA01 JA13 JA17 JA30 JA32 JA51 KA06 KA07 KA20 LA03 LA04 LA08 LA10 MA21 MA27 PA06 5F046 CC01 CC02 CC15 CC18

(54) 【発明の名称】 ステージ装置およびそれを用いた露光装置

(57)【要約】

【課題】 ステージ可動部がステップ移動した時に発生するギャップ変動量を低減できるステージ装置、および該ステージ装置を備えてスループットおよび露光精度の向上が可能な露光装置を提供する。

【解決手段】 ステージ装置は、原版および基板の両方または基板を搭載して移動自在な移動ステージと、該移動ステージをステージ定盤および/またはヨーガイド6に対し支持し案内する静圧パッド10と、該移動ステージを該ステージ定盤および/またはヨーガイド6の間の吸引力およびギャップ量の少なくとも一方を制御する手段(吸引与圧マグネット11、ピエゾ12、ギャップセンサ13等)を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 移動ステージと、該移動ステージを所定の案内面に対しギャップを介して支持する静圧パッドと、該移動ステージを前記案内面に対し吸引与圧する吸引与圧手段とを有するステージ装置において、

前記吸引与圧手段の吸引与圧力を制御する吸引与圧力制御手段を有することを特徴とするステージ装置。

【請求項2】 前記静圧パッドおよび/または前記吸引与圧手段と前記案内面の間のギャップ量を計測する計測手段をさらに備え、前記吸引与圧力制御手段は、該計測手段からの信号に応じて前記吸引与圧力を制御することを特徴とする請求項1に記載のステージ装置。

【請求項3】 前記移動ステージが前記案内面と対向する部分である可動部を複数有し、前記計測手段は、この複数の可動部に対応してそれぞれ複数個所設けられ、前記吸引与圧力制御手段は、前記移動ステージの移動方向および動作状態により、前記計測手段による計測タイミングおよび計測値を選択制御することを特徴とする請求項1または2に記載のステージ装置。

【請求項4】 前記吸引与圧力制御手段は、前記移動ステージの移動動作および/または駆動信号に同期して前記吸引与圧力を制御することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のステージ装置。

【請求項5】 前記吸引与圧力制御手段は、前記移動ステージの移動動作時に発生する外乱要因から予測制御するフィードフォワード制御により前記吸引与圧力を制御することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記、載のステージ装置。

【請求項6】 前記吸引与圧力制御手段は、前記吸引与 圧手段と前記案内面の間のギャップ量を変位制御するこ とにより前記吸引与圧力を制御することを特徴とする請 求項1~5のいずれか1項に記載のステージ装置。

【請求項7】 前記吸引与圧手段が、磁石またはバキュームパッドであることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載のステージ装置。

【請求項8】 前記吸引与圧手段が、バキュームパッドであり、前記吸引与圧力制御手段は、前記バキュームパッドにおけるバキューム圧力を可変制御することにより前記吸引与圧力を制御することを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載のステージ装置。

【請求項9】 移動ステージと、該移動ステージを所定の案内面に対しギャップを介して支持する複数の静圧パッドと、該移動ステージを駆動する駆動手段とを有するステージ装置において、

前記静圧パッドの圧力を前記移動ステージの移動に同期 して可変制御することにより、前記静圧パッドと前記案 内面の間のギャップ量を制御するギャップ制御手段を有 することを特徴とするステージ装置。

【請求項10】 前記ギャップ制御手段は、互いに相対 する静圧パッド面を有する前記静圧パッドの圧力につい ては互いに逆相で可変制御することを特徴とする請求項 9に記載のステージ装置。

【請求項11】 前記案内面が、前記移動ステージを垂直方向に支持するステージ定盤の上面または前記移動ステージを所定方向に案内するガイドの案内面であることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載のステージ装置。

【請求項12】 原版に描かれたパターンを投影光学系を介して基板に投影し、該投影光学系に対し該基板または該原版と該基板の両方をステージ装置により相対的に移動させることにより、該原版のパターンを該基板に繰り返し露光する露光装置であって、

前記ステージ装置の少なくとも1つが請求項1~11の いずれか1項に記載のステージ装置であることを特徴と する露光装置。

【請求項13】 請求項12に記載の露光装置において、ディスプレイと、ネットワークインタフェースと、ネットワーク用ソフトウェアを実行するコンピュータとをさらに有し、露光装置の保守情報をコンピュータネットワークを介してデータ通信することを可能にしたことを特徴とする露光装置。

【請求項14】 前記ネットワーク用ソフトウェアは、前記露光装置が設置された工場の外部ネットワークに接続され前記露光装置のベンダもしくはユーザが提供する保守データベースにアクセスするためのユーザインタフェースを前記ディスプレイ上に提供し、前記外部ネットワークを介して該データベースから情報を得ることを可能にすることを特徴とする請求項13に記載の露光装置。

【請求項15】 請求項12に記載の露光装置を含む各種プロセス用の製造装置群を半導体製造工場に設置する工程と、該製造装置群を用いて複数のプロセスによって半導体デバイスを製造する工程とを有することを特徴とする半導体デバイス製造方法。

【請求項16】 前記製造装置群をローカルエリアネットワークで接続する工程と、前記ローカルエリアネットワークと前記半導体製造工場外の外部ネットワークとの間で、前記製造装置群の少なくとも1台に関する情報をデータ通信する工程とをさらに有することを特徴とする請求項15に記載の半導体デバイス製造方法。

【請求項17】 前記露光装置のベンダもしくはユーザが提供するデータベースに前記外部ネットワークを介してアクセスしてデータ通信によって前記製造装置の保守情報を得る、もしくは前記半導体製造工場とは別の半導体製造工場との間で前記外部ネットワークを介してデータ通信して生産管理を行うことを特徴とする請求項16に記載の半導体デバイス製造方法。

【請求項18】 請求項12に記載の露光装置を含む各種プロセス用の製造装置群と、該製造装置群を接続するローカルエリアネットワークと、該ローカルエリアネッ

トワークから工場外の外部ネットワークにアクセス可能 にするゲートウェイを有し、前記製造装置群の少なくと も1台に関する情報をデータ通信することを可能にした ことを特徴とする半導体製造工場。

【請求項19】 半導体製造工場に設置された請求項1 2に記載の露光装置の保守方法であって、前記露光装置 のベンダもしくはユーザが、半導体製造工場の外部ネットワークに接続された保守データベースを提供する工程 と、前記半導体製造工場内から前記外部ネットワークを 介して前記保守データベースへのアクセスを許可する工 程と、前記保守データベースに蓄積される保守情報を前 記外部ネットワークを介して半導体製造工場側に送信す る工程とを有することを特徴とする露光装置の保守方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体露光装置の 可動ステージや工作機械の可動テーブルに用いられて、 高速かつ高精度な位置決めを必要とされるステージ装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造過程においては、レチクルまたはマスク等の原版のパターンをウエハ(シリコンウエハ)等の基板上に投影して転写するための露光装置が用いられる。この露光装置においては、レチクルパターンをシリコンウエハ上に投影露光する際、シリコンウエハを投影露光系に対して順次ステップ移動するためのウエハステージが用いられる。また、いわゆる走査型投影露光装置(スキャナ)においては、さらにレチクルとシリコンウエハを投影露光系に対して同期して走査するためのレチクルステージも用いられる。

【0003】図19は、従来のステージ装置の全体斜視 図である。同図において、51はレチクル基板に描かれ たレチクルパターンを縮小露光系を通して投影転写する ために、単結晶シリコン基板表面にレジストが塗られた ウエハ、52はウエハ51を縮小露光系の光軸方向およ びチルト方向および光軸中心の回転方向に微動調整する 微動ステージである。また、53は微動ステージ52の X軸方向の移動を案内するXガイド、54は微動ステー ジ52をX方向に移動駆動するXリニアモータ、55は Xガイド53および微動ステージ52をY方向に移動案 内するYスライダ、56はYスライダ55をY方向にガ イドするヨーガイドである。そして、57はYスライダ 55をY方向に移動駆動するYレリニアモータ、58も 同じくYスライダ55をY方向に移動駆動するYRリニ アモータ、59はステージ定盤である。微動ステージ5 2およびYスライダ55は、それらの下面にステージ定 盤59の上面に対向して設けられた静圧パッドによりス テージ定盤59上に浮上され、ステージ定盤59により 上下方向で支持案内される。

【0004】図20は、図19のYスライダ55およびヨーガイド56の構成を示す平面図であり、図21は、Yスライダ55の側面図である。図20および図21において、60はYスライダ55の側面に設けられ、ヨーガイド56に対して静圧を発生させ、エアーベアリングとなる静圧パッド、61は静圧パッド60の浮上力に対してヨーガイド56に対し磁気吸引力を発生させる吸引与圧マグネットである。このように、吸引与圧マグネット61により吸引与圧を静圧パッド60面の静圧面にかけることによって、エアーベアリングギャップ量を調整し、かつ静圧剛性を上げている。

【0005】図22は、吸引与圧マグネット61のヨー ガイド56に対するギャップ量対与圧力特性を示すグラ フである。ギャップ量の調整は、静圧パッド60とヨー ガイド56の静圧ギャップが5 [μm]となるように静 圧パッド60の圧力と吸引与圧マグネット61のギャッ プを調節しながら、吸引与圧マグネット61とヨーガイ ド56とのギャップを調整する。調整ポイントは、吸引 与圧マグネット61とヨーガイド56とのギャップ量を 50 [µm]程度の位置に合わせ込むと、与圧力として はほぼ50[kgf]程度を中心に与圧力を発生させる ポイント、つまり図22に示す吸引与圧マグネット調整 ポイントとする。このように、吸引与圧マグネット61 とヨーガイド56とのギャップを50 [µm] 程度の位 置に合わせ込むと、静圧パッド60とヨーガイド56と のギャップ量が5 [μm]での浮上力50 [kgf]と バランスするため、静圧パッド60のギャップ量は5 [μm]に調整される。

【0006】以上説明した構成で、微動ステージ52を X方向にステップ移動させる際、Xリニアモータ54に 発生するX方向の反力がYスライダ55に伝達され、静 圧パッド60の静圧ギャップにX方向の反力の加速度変 動によるギャップ量変動が発生する。

【0007】図23は、図19のステージ装置における X方向のステップ移動時のギャップ量変動波形を示すグラフである。図23において、横軸を時間、縦軸をギャップ量とし、ギャップ量の中心を調整ギャップ量である 5 [μm]とする。微動ステージ52の-X方向のステップ移動により、まず+X、次いで-Xの順にX方向の 反力加速度変化による静圧ギャップ変動が図23のグラフに示す波形で発生する。図23のグラフにおいて、ステップ時間は整定を含めてTa[sec]となる。ここで、ギャップ量変動は5±2[μm]発生する。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】従来例においては、図23のグラフに示す微動ステージ52のステップ時間Taを短縮する目的でX方向のステップ移動加速度をさらに上げていくと、ギャップ量変動が5±5[μm]になった時点でギャップ量が全て食われ、それ以上加速度が上げられなくなる欠点があった。さらに、上下(2軸)

方向のギャップ量変動についても上記した平面 (XY平面) 方向のギャップ量変動と同様の問題があった。

【0009】本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、ステージ可動部(移動ステージ)の移動時に発生するギャップ変動量を低減し、整定時間の短縮を図ることができるステージ装置、および該ステージ装置を備えてスループットおよび露光精度の向上が可能な露光装置を提供することを課題とする。

[0010]

【課題を解決するための手段および作用】上記課題を解決するために、本発明に係る第1のステージ装置は、移動ステージと、該移動ステージを所定の案内面に対しギャップを介して支持する静圧パッドと、該移動ステージを前記案内面に対し吸引与圧する吸引与圧手段とを有するステージ装置において、前記吸引与圧手段の吸引与圧力を制御する吸引与圧力制御手段を有することを特徴とする。

【0011】本発明によれば、吸引与圧手段の吸引与圧力を制御するようにしたため、移動ステージの移動時に発生する静圧パッドのギャップ変動を打ち消すように吸引与圧力を制御すれば、移動後停止させた際、または移動開始して定速走行をさせた際の整定時間を短縮し、停止時の位置きめ精度を向上させることができる。

【〇〇12】本ステージ装置においては、前記静圧パッドおよび/または前記吸引与圧手段と前記案内面の間のギャップ量を計測する計測手段をさらに備え、前記吸引与圧力制御手段は、該計測手段からの信号に応じて前記吸引与圧力をフィードバック制御することが好ましい。また、前記移動ステージが前記案内面と対向する部分である可動部を複数有する場合、前記計測手段は、この複数の可動部に対応してそれぞれ複数個所設けられ、前記吸引与圧力制御手段は、前記移動ステージの移動方向および計測値を選択制御することが可能である。また、前記吸引与圧力制御手段は、前記移動ステージの移動作および/または駆動信号に同期して前記吸引与圧力を制御することが可能である。

【 O O 1 3】前記ステージ装置において、前記吸引与圧力制御手段は、前記移動ステージの移動動作時に発生する外乱要因から子測制御するフィードフォワード制御により前記吸引与圧力を制御することが好ましい。

【〇〇14】前記吸引与圧力制御手段は、例えば前記吸引与圧手段と前記案内面の間のギャップ量を変位制御することにより前記吸引与圧力を制御する。前記吸引与圧手段としては、例えば磁石またはバキュームパッドが用いられる。なお、前記吸引与圧手段が、バキュームパッドである場合、前記吸引与圧力制御手段は、前記バキュームパッドにおけるバキューム圧力を可変制御することにより前記吸引与圧力を制御することが可能である。

【0015】本発明に係る第2のステージ装置は、移動

ステージと、該移動ステージを所定の案内面に対しギャップを介して支持する複数の静圧パッドと、該移動ステージを駆動する駆動手段とを有するステージ装置において、前記静圧パッドの圧力を前記移動ステージの移動に同期して可変制御することにより、前記静圧パッドと前記案内面の間のギャップ量を制御するギャップ制御手段を有することを特徴とする。ここで、前記ギャップ制御手段は、互いに相対する静圧パッド面を有する前記静圧パッドの圧力については互いに逆相で可変制御すると良い。

【0016】さらに、前記ステージ装置において、前記 案内面は、例えば前記移動ステージを垂直方向に支持す るステージ定盤の上面または前記移動ステージを所定方 向に案内するガイドの案内面とすることができる。

【0017】本発明の露光装置は、原版に描かれたパターンを投影光学系を介して基板に投影し、該投影光学系に対し該基板または該原版と該基板の両方をステージ装置により相対的に移動させることにより、該原版のパターンを該基板に繰り返し露光する露光装置であって、前記ステージ装置の少なくとも1つが上述したいずれかのステージ装置であることを特徴とする。

[0018]

【発明の実施の形態】次に、本発明の好ましい実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。

[第1の実施形態] 図1は、本発明の一実施形態に係る ステージ装置の全体斜視図である。このステージ装置 は、投影露光装置のウエハステージとして用いられる。 図1において、1はレチクル基板に描かれたレチクルパ ターンを縮小露光系を通して投影転写するために、単結 晶シリコン基板表面にレジストが塗られたウエハ、2は ウエハ1を縮小露光系の光軸方向およびチルト方向およ び光軸中心の回転方向に微動調整する微動ステージ、3 は微動ステージ2のX軸方向の移動を案内するXガイド である。また、4は微動ステージ2をX方向に移動駆動 するXリニアモータ、5はXガイド3および微動ステー ジ2をY方向に移動案内するYスライダ、6はYスライ ダをY方向にガイドするヨーガイドである。そして、7 はYスライダ5をY方向に移動駆動するYLリニアモー タ、8も同じくYスライダ5をY方向に移動駆動するY Rリニアモータであり、9はステージ定盤である。微動 ステージ2およびYスライダ5は、それぞれの下面に設 けられた静圧パッドにより浮上され、ステージ定盤9に 対して上下方向で支持案内される。

【0019】図2は、図1のステージ装置の主要部の平面図であり、図3は、図1のステージ装置の主要部の側面図である。図2および図3において、10はYスライダ5の側面に設けられ、ヨーガイド6に対して静圧を発生させ、エアーベアリングとなる静圧パッドである。11は静圧パッド10の浮上力(+X方向の力)に対してヨーガイド6に対し磁気吸引力(-X方向の力)を発生

させる吸引与圧マグネットであり、吸引与圧を静圧パッド10の静圧面にかけることによって、エアーベアリングギャップ量を調整し、かつ静圧剛性を上げている。12は積層型のピエゾ(圧電素子)であり、吸引与圧マグネット11をヨーガイド6とのギャップ方向に、組み込み調整ギャップから±50[μm]程度変位駆動する能力を有する。13はギャップセンサである。

【0020】図4は、図2における静圧パッド10、吸 引与圧マグネット11およびギャップセンサ13等の構 成を示す図であり、図5は、図4における吸引与圧マグ ネット11とヨーガイド6の間のギャップ量対吸引与圧 マグネットによる与圧力特性を示すグラフである。ここ で、組み立て時のギャップ(組み立て調整ギャップ)量 の調整は、図4および図5に示すように、静圧パッド1 Oとヨーガイド6の静圧ギャップが5 [μm]のとき、 吸引与圧マグネット11とヨーガイド6とのギャップ1 4が図5に示す与圧マグネット調整ギャップポイントA の50 [µm] となるように調整する。この与圧マグネ ット調整ギャップポイントAは、ギャップ14を50 [μm]程度の位置に合わせ込むと、与圧力としてはほ ぼ50 [kgf] 程度を中心に与圧力を発生させるポイ ントである。結果、定常動作時は、この与圧力50[k gf] が静圧パッド10とヨーガイド6の間の静圧ギャ ップ5 [μm]での静圧力50 [kgf]とバランス し、静圧パッド10の静圧ギャップは5 [μm] に調整 される。

【0021】以上の構成で、吸引与圧力制御をしない状態では、微動ステージ2をX方向にステップ移動させる際、Xリニアモータ4に発生するX方向の反力がYスライダ5に伝達され、静圧パッド10の静圧ギャップに入りの加速度変動によるギャップ量変動が、図6(b)に示す破線波形、すなわち上記した図23の実線のように発生する。図6(b)においては、横軸に時間、縦軸にギャップ量を示し、ギャップ量の中心を調整ギャップラ としている。微動ステージ2のX方向の反力加速度変化による静圧ギャップ変動が図6(b)のグラフに破線で示す波形で発生する。図6(b)のグラフにおいて、ステップ時間は整定を含めてTa[をで](図中の破線参照)となる。ここで、ギャップ量変動は5±2[μm]発生する。

【0022】本実施形態では、図4に示すように、与圧吸引マグネット11をギャップ方向に±50 [μm]程度駆動変位させる能力を有するピエゾ(圧電素子)12を与圧吸引マグネット11の背面に接合して設ける。さらに、Yスライダ5の端面にヨーガイド6とのギャップ変動を計測するギャップセンサ13を設ける。このギャップセンサ13により検出されたギャップ変動量信号を、ギャップセンサプリアンプ15により増幅し、与圧マグネットギャップ制御回路16によりギャップ変動量

信号から適切な吸引与圧力変化量を算出し、ピエゾ駆動ドライバ17にピエゾ12の駆動指令値を与える。ピエゾ12は、この駆動指令値に応じてピエゾ駆動ドライバ17から発生する駆動電圧により駆動変位する。また、計測手段であるギャップセンサ13等による計測タイミングおよび計測値を選択制御することも可能である。

【0023】図5に示すように、吸引与圧マグネット1 1とヨーガイド6の間のギャップ14を組み立て調整時の与圧マグネット調整ギャップポイントAから与圧制御最大ギャップポイントBおよび与圧制御最小ギャップポイントCまで駆動変位させることにより、吸引与圧力を50±10[kgf]の範囲で可変に制御し、図6

(a) に示す波形のように、X方向のステップ移動時のギャップ変動波形に同期するように吸引与圧力を制御する。ここで、図6(a)は、図1のステージ装置におけるX方向のステップ移動時の吸引与圧力制御波形の時間特性を示すグラフであり、横軸は時間、縦軸は与圧力をそれぞれ示す。

【0024】このように吸引与圧力を制御することにより、X方向のステップ移動時に発生する反力が十方向に働く時には、吸引与圧力が一方向に大きく(60 [k g f])なり、逆に反力が一方向に働く時には、吸引与圧力が一方向に小さく(40 [k g f])なる。X方向のステップ移動時の反力を相殺する方向に吸引与圧力を制御することにより、図6(b)に示す実線波形のように、ギャップ変動量を5±1 [μm]に低減することができる。

【0025】さらに、ギャップ変動量の低減と合わせて 減衰が改善されるため、ステップ移動時の整定までのス テップ時間を吸引与圧力制御無しの状態におけるTa [sec]からTb[sec]に低減することができ る。

【0026】本実施形態では静圧パッドのギャップ変動 量の計測手段を設け、該計測手段からの計測信号によ り、静圧パッドの吸引与圧手段である吸引与圧マグネッ トの与圧力をX方向のステップ移動時に発生するギャッ プ変動に対して可変に制御し、X方向のステップ移動の 反力に対して逆方向に吸引力を変化させることにより、 X方向のステップ移動反力を低減することができる。結 果として、X方向のステップ移動時に発生するヨーガイ ドと静圧パッドとのギャップ変動量を低減し、最終的に X方向のステップ移動加速度をさらに上げることが可能 になる。同時に、同一加速度ではギャップ変動量が低減 されることにより、X方向のステップ移動時の静圧パッ ドのギャップ変動量の減衰を改善し、静止精度の向上を 図れ、露光装置のウエハステージとして用いれば露光装 置トータルのスループットや露光精度を向上させること が可能な露光装置を提供できる。

【0027】[第2の実施形態]図7は、本発明の第2の実施形態に係るステージ装置の主要部の平面図であ

り、図8は、図7のヨーガイド6を除外したステージ装置の主要部の側面図である。図7および図8において、図2および図3と同一の符号は図2および図3と同様の構成要素を示す。

【0028】図7および図8に示すステージ装置は、吸引与圧手段として図2および図3に示す吸引与圧マグネット11の代わりに吸引与圧バキュームパッド18を用いたものであり、バキューム与圧をかけて吸引する方式のものである。

【0029】図9は、図7における静圧パッド10、吸 引与圧バキュームパッド18およびギャップセンサ13 等の構成を示す図であり、図10は、図9における吸引 与圧バキュームパッド18とヨーガイド6の間のバキュ ーム圧力対与圧力特性を示すグラフである。 図9に示す ように、吸引与圧バキュームパッド18はバキューム圧 力を変えることにより、吸引与圧力を50±10[kg f]程度可変する能力を有する。さらに第1の実施形態 と同様に、Yスライダ5の端面に、ヨーガイド6とのギ ャップ変動を計測するギャップセンサ13を設ける。こ のギャップセンサ13により検出されたギャップ変動量 信号を、ギャップセンサプリアンプ15により増幅し、 与圧パッド制御回路19によりギャップ変動量信号から 適切な吸引与圧力変化量を算出し、バキュームパッド圧 力調整手段20に圧力指令値を与える。この圧力指令値 に応じてバキュームパッド圧力調整手段20が発生する バキューム圧力信号により、吸引与圧バキュームパッド 18の吸引与圧力を変化させる。

【0030】ここで、図10に示すように、吸引与圧バキューム圧力を、組み立て調整時の吸引与圧バキュームパッド調整圧力ポイントAから与圧制御最大バキューム圧力ポイントBおよび与圧制御最小バキューム圧力ポイントCまで変化させることにより、吸引与圧力を50±10[kgf]の範囲で可変制御し、図6(a)に示す波形のように、X方向のステップ移動時のギャップ変動波形に同期するように吸引与圧力を制御する。

【0031】結果、吸引与圧力を制御することにより、X方向のステップ移動時に発生する反力が+方向に働く時には、吸引与圧力が-方向に大きく(60[kgf])なり、逆に反力が-方向に働く時には、吸引与圧力が-方向に小さく(40[kgf])なる。X方向のステップ移動時の反力を相殺する方向に吸引与圧力を制御することにより、図6(b)に示す実線波形のように、ギャップ変動量を $5\pm1[\mu m]$ に低減できる。

【0032】さらに、ギャップ変動量の低減と合わせて 減衰が改善されるため、ステップ移動時の整定までのス テップ時間を吸引与圧力制御無しの状態でのTa[se c]からTb[sec]に低減できる。

【0033】[第3の実施形態]上記した実施形態では、YスライダとYガイド間の静圧パッドの与圧力制御について述べたが、他にYスライダとステージ定盤、お

よび微動ステージとステージ定盤間の上下方向の静圧パッド間に発生するピッチングおよびローリング方向のギャップ変動についても、同じく上下ギャップ検出手段を設けて、与圧力制御でギャップ変動量を低減することが可能である。

【0034】[第4の実施形態]上記した実施形態では、X方向にステップ移動したときのX方向のギャップ変動についての与圧力制御について述べたが、他にY方向のステップ移動およびX方向のステップ移動とY方向のステップ移動を同時に行った際の斜めステップ移動時に発生するヨーイング方向(Z軸周りの回転モード)のギャップ変動等についても、同じくギャップセンサによるギャップ量変動として検出して、それぞれの静圧パッドの吸引与圧手段の与圧力を制御することにより、ヨーイング方向のギャップ変動を低減することが可能である。

【0035】[第5の実施形態]上記した実施形態では、マグネットとピエゾ駆動による吸引与圧力制御手段ならびにバキュームパッドと圧力調整手段による吸引与圧力制御手段を用いた例を示したが、他に吸引バキュームパッドとピエゾ駆動による吸引与圧力制御手段も可能である。この場合、バキュームパッドの吸引圧力は一定または無制御とし、ピエゾによりバキュームパッドとガイド定盤の間のギャップ量を変えることにより吸引与圧力を制御し、静圧パッドのギャップ変動を低減することが可能である。勿論、バキュームパッドの吸引圧力とピエゾによるギャップ量の双方を制御するようにしてもよい。

【0036】[第6の実施形態]上記した実施形態では、マグネットまたはバキュームパッド等の吸引与圧手段の駆動変位手段としてピエゾ(圧電素子)を用いているが、他にマグネットコイルと電磁ヨークの組み合わせ等の電磁駆動手段やダイヤフラム等の空圧駆動手段等でも駆動制御が可能である。

【0037】[第7の実施形態]図11は、第7の実施形態に係るステージ装置のギャップ変動に対するギャップ制御方式を示す制御ブロック図である。上記した第1~第6の実施形態では、静圧パッドのギャップ計測手段からの信号をフィードバックしてピエゾ変位量を制御するフィードバック制御を行っているが、本実施形態では、予めステージの駆動状態と静圧パッドのギャップ変動量の関係を計測しておき、ステージの実働時は各駆動状態におけるギャップ変動量を予測し、図11(a)に示すように、ステージ装置の駆動プロファイルに同期してギャップ変動量を子め目標位置指令に外乱要因として加えるFF制御(フィードフォワード制御)による予圧力制御を行い、ギャップ変動量を減少させる。図11(b)は、第1~第6の実施形態におけるフィードバック制御と上記のフィードフォワードを組み合わせたもの

で、ここでは、予測したギャップ変動量ステージ装置の

駆動プロファイルに同期してギャップ制御量に加え、ギャップ変動量をさらに減少させる。

【0038】以上のように、静圧パッドの吸引与圧手段である吸引与圧マグネットの与圧力を、X,Y方向のステップ移動時に発生する各静圧パッドのギャップ変動に対して可変に制御することにより、X,Y方向のステップ移動時に発生するヨーガイドと静圧パッドとのギャップ変動およびYスライダとステージ定盤および微動ステージとステージ定盤とのギャップ変動を低減し、最終的にX,Y方向のステップ移動の加速度をさらに上げることが可能になる。それと同時に、同一加速度ではギャップ変動量が低減されることにより、X,Y方向のステップ移動時の静圧パッドのギャップ変動の減衰を改善できる。そして、本発明によるステージ装置を用いた露光装置は、ステッパ露光装置では窓光時の静止精度の向上が図れる。

【0039】[第8の実施形態]図12は、第8の実施形態に係るステージ装置における構成を示す図であり、同図において、図1と同一の符号は図1と同様の構成要素を示す。上記した実施形態では、静圧パッドと吸引与圧手段の組み合わせにより吸引与圧力を可変に制御しているが、吸引与圧手段を有さずに、Xガイド3に対して両サイドから挟む形態で静圧パッド(Aパッド31、Bパッド32)を設けた場合は、両静圧パッド31、Bパッド32)を設けた場合は、両静圧パッド31、32の静圧力を、プッシュプルで制御することにより、ギャップ変動量を減少させることも可能である。

【0040】図13は、図12における×方向のステップ移動による反力下に対するギャップ変動量と静圧力の時間変動波形を示すグラフであり、上から順に時間下に対する反力下の変動波形、時間下に対するプッシュプル制御ON/OFFの場合のAパッドギャップ変動波形、時間下に対するイッシュプル制御ON/OFFの場合のBパッドギャップ変動波形、時間下に対するAパッド静圧力の制御波形、時間下に対するBパッド静圧力の制御波形、時間下に対するBパッド静圧力の制御波形、時間下に対するBパッド静圧力の制御波形をそれぞれ示す。ここで、図12における反力下の+/-の方向は、図13のグラフにおける方向と同様とする。

【0041】図12および図13において、微動ステージのステップ移動による反力下によるAパッド31およびBパッド32のギャップ変動量をプッシュプル制御により低減させることが可能である。すなわち、+方向の反力下が発生した場合とすると、Aパッド31側のギャップ量が減少しBパッド側のギャップ量が増加するので、Aパッド31の静圧力を増加(プッシュ)させ、Bパッド31の静圧力を減少(プル)させる。一方向の反力下についてもBパッド32およびAパッド31の静圧力をギャップ変動波形に同期するようにAパッド31およびBパッド32共に4±1[kgf/cm²]の範

囲でプッシュプル制御(Aパッド31およびBパッド32は互いに逆相に静圧力を可変制御)した例を示す。 【0042】[第9の実施形態]上述の実施形態においては、本発明に係るステージ装置をステップアンドリピート方式の投影露光装置(ステッパ)およびステップアンドスキャン方式の投影露光装置(スキャナ)の基板(ウエハ)ステージとして用いる例を示したが、本発明のステージ装置は、露光時、基板と原版(レチクル等)を投影光学系に対して相対的に走査(スキャン)するスキャナの原版ステージとして用いることもできる。

【0043】 [半導体生産システムの実施形態]次に、上記説明した露光装置を利用した半導体等のデバイス(ICやLSI等の半導体チップ、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等)の生産システムの例を説明する。これは、半導体製造工場に設置された製造装置のトラブル対応や定期メンテナンス、もしくはソフトウェア提供等の保守サービスを、製造工場外のコンピュータネットワーク等を利用して行うものである。

【0044】図14は、全体システムをある角度から切 り出して表現したものである。図中、101は半導体デ バイスの製造装置を提供するベンダ(装置供給メーカ) の事業所である。製造装置の実例として、半導体製造工 場で使用する各種プロセス用の半導体製造装置、例え ば、前工程用機器(露光装置、レジスト処理装置、エッ チング装置等のリソグラフィ装置、熱処理装置、成膜装 置、平坦化装置等)や後工程用機器(組立て装置、検査 装置等)を想定している。事業所101内には、製造装 置の保守データベースを提供するホスト管理システム1 08、複数の操作端末コンピュータ110、これらを結 んでイントラネット等を構築するローカルエリアネット ワーク(LAN)109を備える。ホスト管理システム 108は、LAN109を事業所の外部ネットワークで あるインターネット105に接続するためのゲートウェ イと、外部からのアクセスを制限するセキュリティ機能 を備える。

【0045】一方、102~104は、製造装置のユーザとしての半導体製造メーカ(半導体デバイスメーカ)の製造工場である。製造工場102~104は、互いに異なるメーカに属する工場であってもよいし、同一のメーカに属する工場(例えば、前工程用の工場、後工程用の工場等)であってもよい。各工場102~104内には、夫々、複数の製造装置106と、それらを結んでイントラネット等を構築するローカルエリアネットワーク(LAN)111と、各製造装置106の稼動状況を監視する監視装置としてホスト管理システム107とが設けられている。各工場102~104に設けられたホスト管理システム107は、各工場内のLAN111を工場の外部ネットワークであるインターネット105に接続するためのゲートウェイを備える。これにより各工場

のLAN111からインターネット105を介してベン ダ101側のホスト管理システム108にアクセスが可 能となり、ホスト管理システム108のセキュリティ機 能によって限られたユーザだけがアクセスが許可となっ ている。具体的には、インターネット105を介して、 各製造装置106の稼動状況を示すステータス情報(例 えば、トラブルが発生した製造装置の症状)を工場側か らベンダ側に通知する他、その通知に対応する応答情報 (例えば、トラブルに対する対処方法を指示する情報、 対処用のソフトウェアやデータ)や、最新のソフトウェ ア、ヘルプ情報等の保守情報をベンダ側から受け取るこ とができる。各工場102~104とベンダ101との 間のデータ通信および各工場内のLAN111でのデー 夕通信には、インターネットで一般的に使用されている 通信プロトコル (TCP/IP) が使用される。なお、 工場外の外部ネットワークとしてインターネットを利用 する代わりに、第三者からのアクセスができずにセキュ リティの高い専用線ネットワーク (ISDN等)を利用 することもできる。また、ホスト管理システムはベンダ が提供するものに限らずユーザがデータベースを構築し て外部ネットワーク上に置き、ユーザの複数の工場から 該データベースへのアクセスを許可するようにしてもよ

【0046】さて、図15は、本実施形態の全体システ ムを図14とは別の角度から切り出して表現した概念図 である。先の例では、それぞれが製造装置を備えた複数 のユーザ工場と、該製造装置のベンダの管理システムと を外部ネットワークで接続して、該外部ネットワークを 介して各工場の生産管理や少なくとも1台の製造装置の 情報をデータ通信するものであった。これに対し本例 は、複数のベンダの製造装置を備えた工場と、該複数の 製造装置のそれぞれのベンダの管理システムとを工場外 の外部ネットワークで接続して、各製造装置の保守情報 をデータ通信するものである。図中、201は製造装置 ユーザ (半導体デバイス製造メーカ) の製造工場であ り、工場の製造ラインには各種プロセスを行う製造装 置、ここでは例として露光装置202、レジスト処理装 置203、成膜処理装置204が導入されている。な お、図15では、製造工場201は1つだけ描いている が、実際は複数の工場が同様にネットワーク化されてい る。工場内の各装置はLAN206で接続されてイント ラネット等を構成し、ホスト管理システム205で製造 ラインの稼動管理がされている。一方、露光装置メーカ 210、レジスト処理装置メーカ220、成膜装置メー カ230等、ベンダ(装置供給メーカ)の各事業所に は、それぞれ供給した機器の遠隔保守を行うためのホス ト管理システム211,221,231を備え、これら は上述したように保守データベースと外部ネットワーク のゲートウェイを備える。ユーザの製造工場内の各装置 を管理するホスト管理システム205と、各装置のベン

ダの管理システム211,221,231とは、外部ネットワーク200であるインターネットもしくは専用線ネットワークによって接続されている。このシステムにおいて、製造ラインの一連の製造機器の中のどれかにトラブルが起きると、製造ラインの稼動が休止してしまうが、トラブルが起きた機器のベンダからインターネット200を介した遠隔保守を受けることで迅速な対応が可能で、製造ラインの休止を最小限に抑えることができる。

【0047】半導体製造工場に設置された各製造装置は それぞれ、ディスプレイと、ネットワークインタフェー スと、記憶装置にストアされたネットワークアクセス用 ソフトウェアならびに装置動作用のソフトウェアを実行 するコンピュータを備える。記憶装置としては内蔵メモ リやハードディスク、もしくはネットワークファイルサ ーバ等である。上記ネットワークアクセス用ソフトウェ アは、専用または汎用のウェブブラウザを含み、例えば 図16に一例を示す様な画面のユーザインタフェースを ディスプレイ上に提供する。各工場で製造装置を管理す るオペレータは、画面を参照しながら、製造装置の機種 401、シリアルナンバー402、トラブルの件名40 3、発生日404、緊急度405、症状406、対処法 407、経過408等の情報を画面上の入力項目に入力 する。入力された情報はインターネットを介して保守デ ータベースに送信され、その結果の適切な保守情報が保 守データベースから返信されディスプレイ上に提示され る。また、ウェブブラウザが提供するユーザインタフェ ースは、さらに図示のごとくハイパーリンク機能41 0,411,412を実現し、オペレータは各項目のさ らに詳細な情報にアクセスしたり、ベンダが提供するソ フトウェアライブラリから製造装置に使用する最新バー ジョンのソフトウェアを引出したり、工場のオペレータ の参考に供する操作ガイド(ヘルプ情報)を引出したり することができる。ここで、保守データベースが提供す る保守情報には、上記説明した本発明に関する情報も含 まれ、また前記ソフトウェアライブラリは本発明を実現 するための最新のソフトウェアも提供する。

【0048】次に、上記説明した生産システムを利用した半導体デバイスの製造プロセスを説明する。図17は、半導体デバイスの全体的な製造プロセスのフローを示す。ステップ1(回路設計)では半導体デバイスの回路設計を行う。ステップ2(マスク製作)では設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ3(ウエハ製造)ではシリコン等の材料を用いてウエハを製造する。ステップ4(ウエハプロセス)は前工程と呼ばれ、上記用意したマスクとウエハを用いて、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。次のステップ5(組み立て)は後工程と呼ばれ、ステップ4によって作製されたウエハを用いて半導体チップ化する工程であり、アッセンブリ工程(ダイシング、

ボンディング)、パッケージング工程(チップ封入)等の組立て工程を含む。ステップ6(検査)ではステップ5で作製された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイスが完成し、これを出荷(ステップ7)する。前工程と後工程はそれぞれ専用の別の工場で行い、これらの工場毎に上記説明した遠隔保守システムによって保守がなされる。また、前工程工場と後工程工場との間でも、インターネットまたは専用線ネットワークを介して生産管理や装置保守のための情報等がデータ通信される。

【0049】図18は、上記ウエハプロセスの詳細なフ ローを示す。ステップ11(酸化)ではウエハの表面を 酸化させる。ステップ12(CVD)ではウエハ表面に 絶縁膜を成膜する。 ステップ 13 (電極形成)ではウエ ハ上に電極を蒸着によって形成する。 ステップ14 (イ オン打込み)ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ 15 (レジスト処理)ではウエハに感光剤を塗布する。 ステップ16(露光)では上記説明した露光装置によっ てマスクの回路パターンをウエハに焼付露光する。ステ ップ17 (現像)では露光したウエハを現像する。ステ ップ18(エッチング)では現像したレジスト像以外の 部分を削り取る。ステップ19(レジスト剥離)ではエ ッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。こ れらのステップを繰り返し行うことによって、ウエハ上 に多重に回路パターンを形成する。各工程で使用する製 造機器は上記説明した遠隔保守システムによって保守が なされているので、トラブルを未然に防ぐと共に、もし トラブルが発生しても迅速な復旧が可能で、従来に比べ て半導体デバイスの生産性を向上させることができる。 [0050]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のステージ 装置によれば、静圧パッドに対する吸引与圧手段による 与圧力を制御するようにしたため、例えば移動ステージ の移動時に発生する各静圧パッドのギャップ変動に対し て吸引与圧力制御手段により制御することで、移動ステージの移動時に発生するギャップ変動量を低減できる。また、移動ステージの移動時における整定までの時間を吸引与圧力制御手段が無い場合に比べて低減できる。そのため、移動ステージのステップ移動における加速度を さらに上げることが可能となる。

【0051】また、静圧パッドの圧力を移動ステージの 駆動に同期して可変制御し、静圧パッドと案内面の間の ギャップ量を制御することにより、可変制御を行わない ときに比べてギャップ変動量を低減できる。

【0052】さらに、本発明の露光装置は、上記したステージ装置を備えることによりギャップ変動量等を低減することができ、ステップ移動時等の移動ステージの移動時における静圧パッドのギャップ変動を改善することができる。そのため、露光装置トータルのスループットや露光精度を向上させることが可能な露光装置を提供す

ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の一実施形態に係るステージ装置の全体斜視図である。
- 【図2】 図1のステージ装置の主要部の平面図である.
- 【図3】 図2のヨーガイドを除外したステージ装置の 主要部の側面図である。
- 【図4】 図2における静圧パッド、吸引与圧マグネットおよびギャップセンサ等の構成を示す図である。
- 【図5】 図4における吸引与圧マグネットとヨーガイドの間のギャップ対吸引与圧マグネットによる与圧力特性を示すグラフである。
- 【図6】 図1のステージ装置におけるX方向へのステップ移動時の吸引与圧力制御波形とギャップ変動波形の時間特性を示すグラフである。
- (a) 吸引与圧力制御波形の時間特性。
- (b)吸引与圧力制御ON(実線)/OFF(破線)の場合のギャップ変動波形の時間特性である。
- 【図7】 第2の実施形態に係るステージ装置の主要部の平面図である。
- 【図8】 図7のヨーガイドを除外したステージ装置の主要部の側面図である。
- 【図9】 図6における静圧パッド、吸引与圧バキュームパッドおよびギャップセンサ等の構成を示す図である
- 【図10】 図8における吸引与圧バキュームパッドと ヨーガイドの間のバキューム圧力対与圧力特性を示すグ ラフである。
- 【図11】 第7の実施形態に係るステージ装置のギャップ変動に対するギャップ制御方式を示す制御ブロック図である。
- (a)第7の実施形態に係るフィードフォワード制御を 示す制御ブロック図である。
- (b)フィードバック制御を示す制御ブロック図である。
- 【図12】 第8の実施形態に係るステージ装置における構成を示す図である。
- 【図13】 図12におけるX方向のステップ移動による反力Fに対するギャップ変動量と静圧力の波形をそれぞれ示すグラフである。
- 【図14】 本発明の一実施形態に係る露光装置を含む 半導体デバイスの生産システムをある角度から見た概念 図である。
- 【図15】 本発明の一実施形態に係る露光装置を含む 半導体デバイスの生産システムを別の角度から見た概念 図である。
- 【図16】 本発明の一実施形態に係る露光装置を含む 半導体デバイスの生産システムにおけるユーザインタフェースの具体例を示す図である。

微動ステージ、53: Xガイド、54: Xリニアモー

タ、55:Yスライダ、56:ヨーガイド、57:YL

リニアモータ、58: YRリニアモータ、59: ステージ定盤、60: 静圧パッド、61: 吸引与圧マグネッ

【図17】 本発明の一実施形態に係る露光装置によるデバイスの製造プロセスのフローを説明する図である。 【図18】 本発明の一実施形態に係る露光装置によるウエハプロセスを説明する図である。

【図19】 従来例に係るステージ装置の全体斜視図である。

【図20】 従来例に係るステージ装置の平面図である。

【図21】 従来例に係るステージ装置の側面図である。

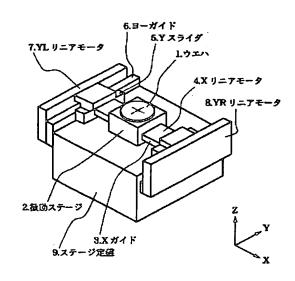
【図22】 従来例に係るステージ装置の吸引与圧マグネットのギャップ量対与圧力特性を示すグラフである。 【図23】 従来例に係るX方向のステップ移動時のギャップ変動波形の時間特性を示すグラフである。

【符号の説明】

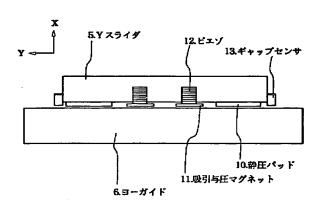
1:ウエハ、2:微動ステージ、3: Xガイド、4: X リニアモータ、5: Yスライダ、6:ヨーガイド、7: YLリニアモータ、8: YRリニアモータ、9:ステージ定盤、10:静圧パッド、11:吸引与圧マグネット、12:ピエゾ、13:ギャップセンサ、14:ギャップ、15:ギャップセンサプリアンプ、16:与圧マグネットギャップ制御回路、17:ピエゾ駆動ドライバ、18:吸引与圧パキュームパッド、19:与圧パッド制御回路、20:バキュームパッド圧力調整手段、31:Aパッド、32:Bパッド、51:ウエハ、52:

ト、101:ベンダの事業所、102,103,10 4:製造工場、105:インターネット、106:製造 装置、107:工場のホスト管理システム、108:ベ ンダ側のホスト管理システム、109:ベンダ側のロー カルエリアネットワーク(LAN)、110:操作端末 コンピュータ、111:工場のローカルエリアネットワ ーク(LAN)、200:外部ネットワーク、201: 製造装置ユーザの製造工場、202:露光装置、20 3:レジスト処理装置、204:成膜処理装置、20 5: 工場のホスト管理システム、206: 工場のローカ ルエリアネットワーク(LAN)、210:露光装置メ ーカ、211:露光装置メーカの事業所のホスト管理シ ステム、220:レジスト処理装置メーカ、221:レ ジスト処理装置メーカの事業所のホスト管理システム、 230:成膜装置メーカ、231:成膜装置メーカの事 業所のホスト管理システム、401:製造装置の機種、 402:シリアルナンバー、403:トラブルの件名。 404:発生日、405:緊急度、406:症状、40 7: 対処法、408: 経過、410, 411, 412: ハイパーリンク機能。

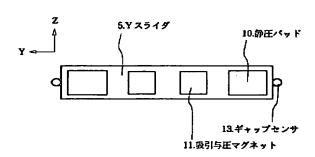
【図1】

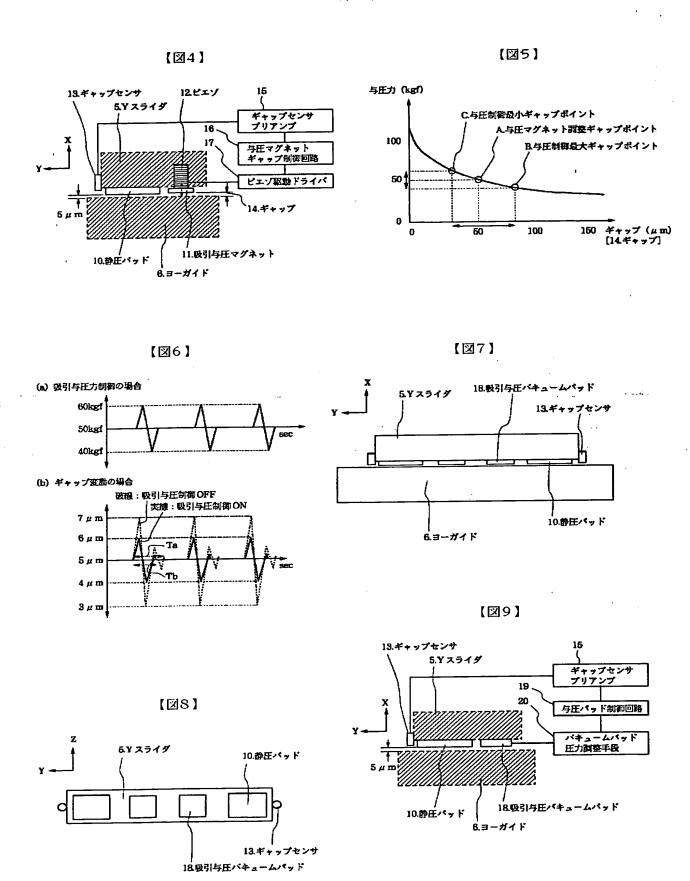


【図2】



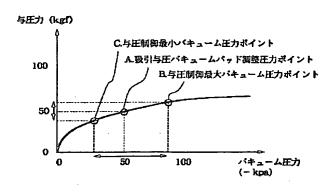
【図3】

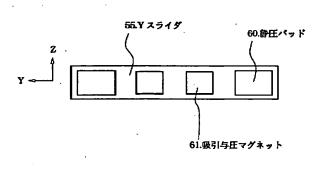




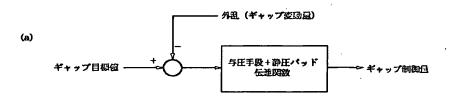


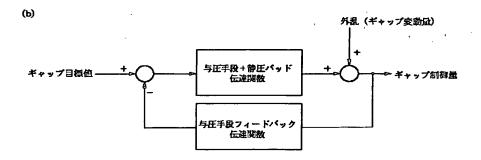
【図21】



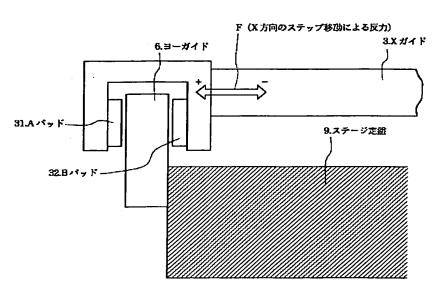


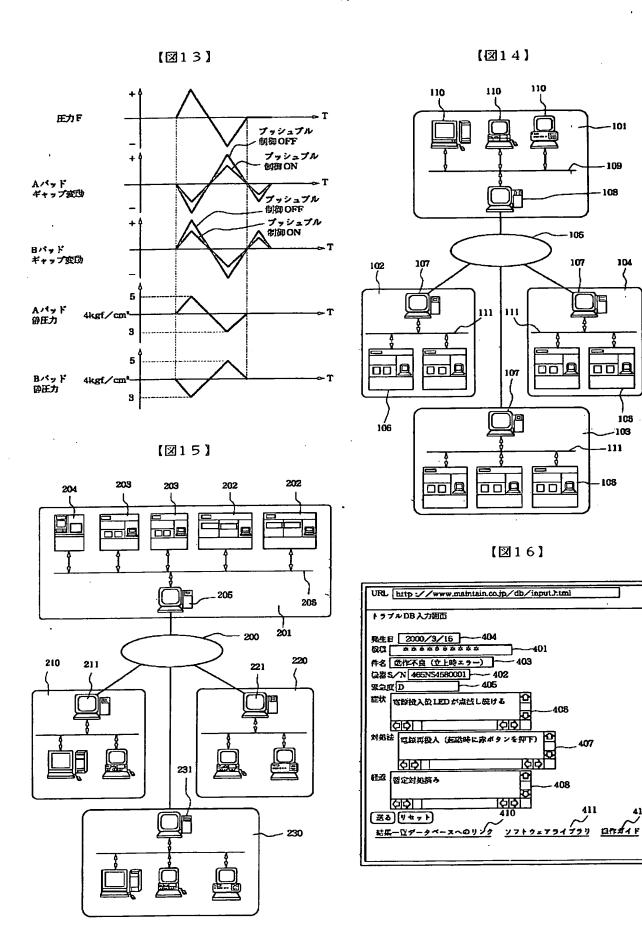
【図11】



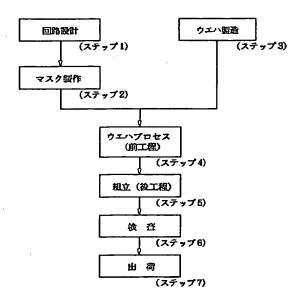


【図12】



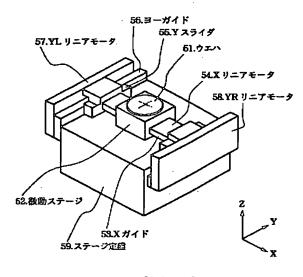


【図17】

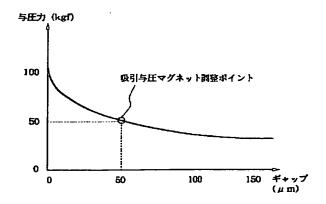


半導体デバイス製造フロー

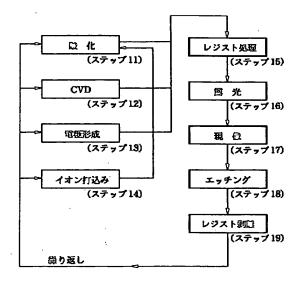
【図19】



【図22】

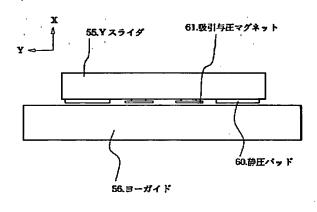


【図18】



ウエハプロセス

【図20】



【図23】